Лабораторная работа № 3.3.4 Эффект Холла в полупроводниках.

Никита Москвитин, Б04-204

2023

1 Аннотация

В данной работе измерялись основные параметры полупроводника. Были получены значения концетрации носителей заряда, их подвижности. Был определен тип полупроводника.

2 Введение

Эффект Холла

Во внешнем магнитном поле \vec{B} на заряды действует сила Лоренца:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{u} \times \vec{B}.$$

Эта сила вызывает движение носителей, направление которого в общем случае не совпадает с \vec{E} . Действительно, траектории частиц будут либо искривляться, либо, если геометрия проводника этого не позволяет, возникнет дополнительное электрическое поле, компенсирующее магнитную составляющую силы Лорнеца. Возникновение попречного току электрического поля в образце, помещённом во внешнее магнитное поле, называют эффектом Холла.

Мостик Холла

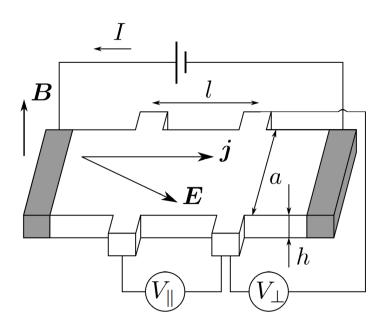


Рис. 1: Схема мостика Холла

Для исследования завиисимости проводимости среды от магнитного поля используют т.н. мостик Холла. В данной схеме (Рис. 1) ток вынуждают течь по оси x вдоль плоской пластинки (ширина пластинки a, толщина h, длина l). Сила Лоренца, действующая со стороны перпендикулярного пластинке магнитного поля, "прибивает"носители заряда к краям образца, что создаёт холловское электрическое поле, компенсирующее эту силу. Поперечное напряжение между краями пластинки (холловское напряжение) равно $U_{\perp} = E_y a$, где

$$E_y = \frac{j_x B}{nq}.$$

Плотность тока, текущего через образец, равна $j_x = \frac{I}{ah}$, где I – полный ток, ah – поперечное сечение. Таким образом, для холловского напряжения имеем

$$U_{\perp} = \frac{B}{naa}I = R_H \frac{B}{a}I,$$

где константу

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

называют $nocmoshhoй\ Xonna$. Знак постоянной Xonna определяется знаком заряда носителей.

Продольная напряжённость электрического поля равна

$$E_x = \frac{j_x}{\sigma_0},$$

и падение напряжения $U_{\parallel}=E_x l\ в donb$ пластинки определяется омическим сопротивлением образца $R_0=rac{l}{\sigma_0 ah}$:

$$U_{\parallel} = IR_0.$$

Интересно отметить, что немотря на то, что тензор проводимости явно зависит от B, продольное сопротивление образца в данной геометрии от магнитного поля ne зависит.

3 Экспериментальная установка

Электрическая схема установки для измерения ЭДС Холла представлена на Рис. 2.

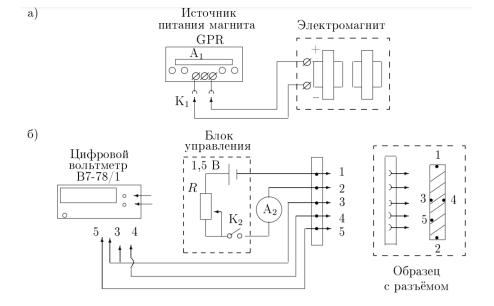


Рис. 2: Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках

В зазоре электромагнита создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регуляторов источника питания. Ток измеряется амперметров источника питания A_1 . Разъём K_1 позволяет менять направление тока в обмотках электромагнита.

Градуировка магнита проводится при помощи милливеберметра.

Образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе, подключается к батарее ($\approx 1,5$ В). При замыкании ключа K_2 вдоль длинной стороны образца течёт ток, величина которого регулируется реостатом R и измеряется миллиамперметром A_2 .

В образце с током, помещённом в зазор электромагнита, между контактами 3 и 4 возникает разность потенциалов U_{34} , которая измеряется с помощью цифрового вольтметра.

Контакты 3 и 4 вследствие неточности подпайки не всегда лежат на одной эквипотенциали, и тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения, вызванным протеканием основного тока через образец. Измеряемая разность потенциалов при одном направлении магнитного поля равна сумме ЭДС Холла и омического падения напряжения, а при другом – их разности. В этом случае ЭДС Холла $\varepsilon_{\rm X}$ может быть определена как половина алгебраической разности показаний вольтметра, полученных для двух противоположных направлений магнитного поля в зазоре. Знак измеряемого напряжения высвечивается на цифровом табло вольтметра.

Можно исключить влияние омического падения напряжения иначе, если при каждом токе через образец измерять напряжение между точками 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение U_0 остаётся неизменным. От него следует (с учётом знака) отсчитывать величину ЭДС Холла: $\varepsilon_{\rm X} = U_{34} \pm U_0$. При таком способе измерения нет неообходимости проводить повторные измерения с противоположным направлением магнитного поля.

По знаку $\varepsilon_{\rm X}$ можно определить характер проводимости – электронный или дырочный. Для этого необходимо знать направление тока в образце и направление магнитного поля. Измерив ток I в образце и напряжение U_{35} между контактами 3 и 5 в отсутствие магнитного поля, можно, зная параметры образца, рассчитать проводимость материала образца по очевидной формуле:

$$\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35}al},$$

где L_{35} – расстояние между контактами 3 и 5, a – толщина образца, l – его ширина.

4 Измерения

Таблица 1: Измерения для ВАХа

І, мА	0,29	0,41	0,5	0,61	0,7	0,8	0,9	1	0,2	0,15
U, мВ	1,135	1,602	1,965	2,389	2,746	3,145	3,526	3,916	0,78	0,58

Таблица 2: Значения ЭДС Холла при токе I=1 мА

_						
	U, мВ	0,388	0,544	$0,\!656$	0,735	0,794
	В, мТл	484,2	668,7	803,2	894,2	958,7

Таблица 3: Значений ЭДС Холла при токе I=0.8 мA

U, MB	0,323	0,429	0,52	0,582	0,633
В, мТл	484,2	668,7	803,2	894,2	958,7

5 Обработка результатов

Из первого графика (Рис.3) мы получаем сопротивление образца $R=\frac{1}{k}=(3,91982\pm0,00265)$ Ом. Посчитаем проводимость $\sigma=\frac{l}{SR}=(3,1889\pm0,0022)$ Ом*см.

Таблица 4: Значений ЭДС Холла при токе $I=0.5~\mathrm{mA}$

1		7 1		1	, ,
U, мВ	0,2	0,269	0,326	0,367	0,397
В, мТл	484,2	668,7	803,2	894,2	958,7

Приведем значения коэффицентов налона в зависимости от тока для графиков ЭДС Холла в зависимости от тока(Рис. 4- 6) в Таблице 5. И построим график коэффицентов наклона от тока, для усредения значений (Рис.7)

Таблица 5: Значения коэффицентов наклона графиков в зависимости от тока

І, мА	0,5	0,8	1
k, В/Тл	4,15274E-4	6,51287E-4	8,5191E-4

Коэффицента наклона нового графика $K=\frac{1}{nae}=(8,36\pm0,13)*10^{-4}~\mathrm{B/T\pi^*mA}$, тогда концетрация $n=(7,47\pm0,12)*10^{15}~\mathrm{cm^3}$. Посчтиаем постоянную Холла $R_H=K*a=(8,36\pm0,13)*10^{-4}~\mathrm{m^3/K\pi}$. А подвижность $\mu=\frac{\sigma}{en}=(2670\pm50)\frac{\mathrm{cm^2}}{\mathrm{B^*c}}$. Получается проводимость n-типа.

6 Вывод

Мы получили для нашего образца такие значения:

проводимость $\sigma = (3, 1889 \pm 0, 0022)$ Ом*см концетрация $n = (7, 47 \pm 0, 12) * 10^{15}$ см³ постоянная Холла $R_H = (8, 36 \pm 0, 13) * 10^{-4}$ м³/Кл подвижность $\mu = (2670 \pm 50) \frac{\text{см}^2}{\text{R*}_c}$

Как мы можем понять из подвижности, это не просто обычный проводник n-типа, так как табличное значение подвижности $\mu=3800\frac{{\rm cm}^2}{{\rm B}^*{\rm c}}$, скорее всего это лигированный германий – с примесями, здесь имеет смысл быть электронно-дырочная проводимость. ПРи этом все цели были выполнены, а так же результаты коррелирует с реальностью.

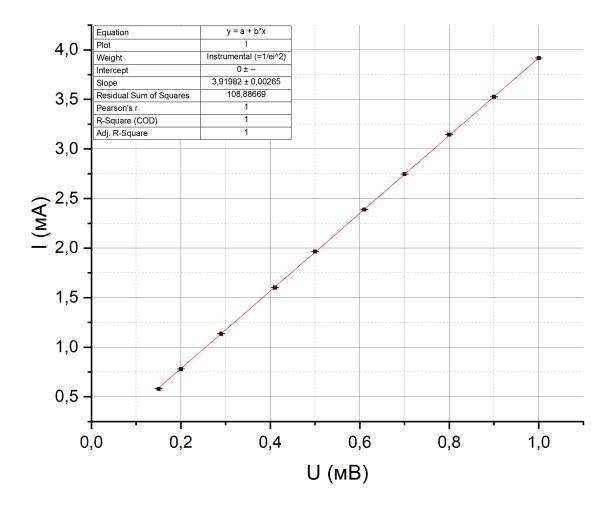


Рис. 3: ВАХ

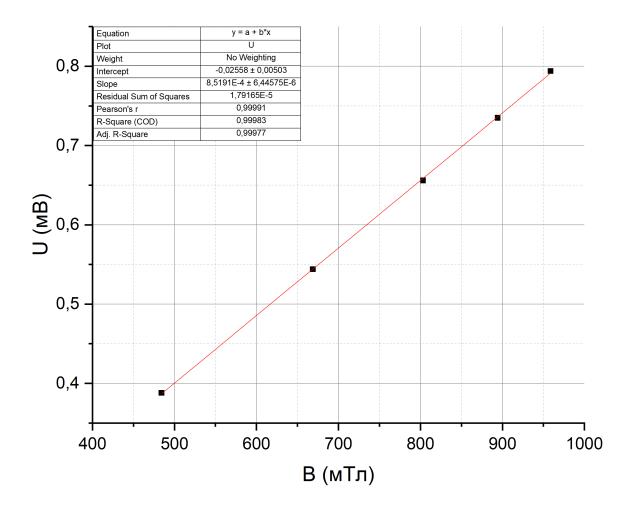


Рис. 4: График зависимости ЭДС Холла от индукции магнитного поля при токе I=1 мА

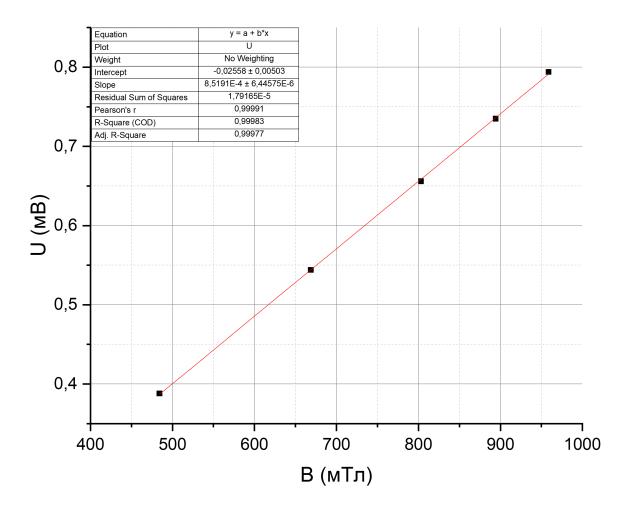


Рис. 5: График зависимости ЭДС Холла от индукции магнитного поля при токе I=0.8 мА

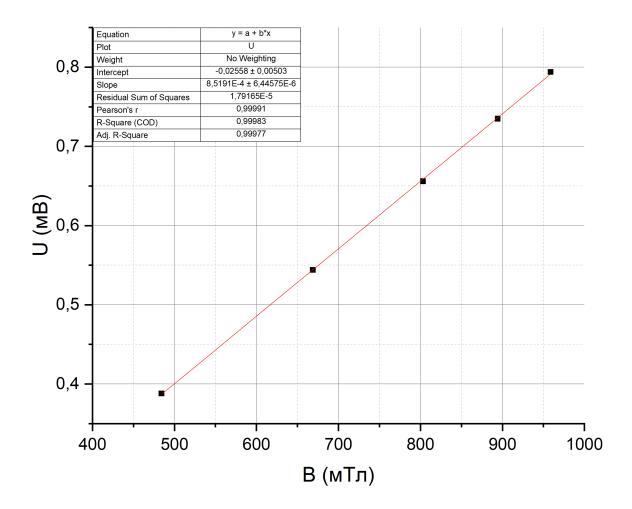


Рис. 6: График зависимости ЭДС Холла от индукции магнитного поля при токе $I=0.5\,$ мА

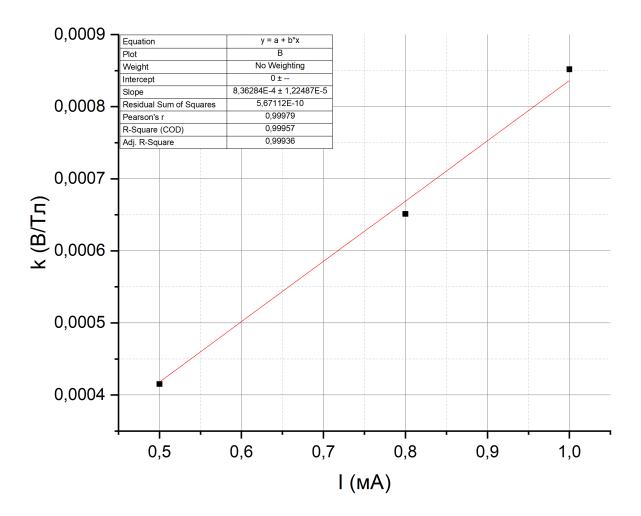


Рис. 7: График зависимости коэффицентов наклона от тока